

P7

中間赤外観測装置用  
極低温バッファ回路のための  
汎用FETの特性検査

岡田一志、宮田隆志、酒向重行、上塚貴史、  
中村友彦、浅野健太郎、内山瑞穂(東京大学)

# 低温プリアンプのためのGaAs FET

- 大規模化が進む中間赤外線観測装置
- 4～20K程度の極低温で動作する低温プリアンプの必要性にせまられる
- 極低温で(安定)動作されるとされているGaAs FETを使い、シンプルなプリアンプを構成したい
- 現在市販されているGaAs FETから、良好な低温特性をもつものを探す

詳細に関してはポスターP7